

مدار مخبراتی

مقدمه سیگنال بزرگ: هر گاه دامنه (ولتاژ) بیس امیتر از ۵ یا ۶ ولت بیشتر باشد در

حوزه سیگنال بزرگ هستیم.

Q_3, Q_2, Q_1 مشابه هستند.

- حال به بررسی مداری می پردازیم که صدق بر گفتار می باشد.

Q_2, Q_3 آینه ای و برای بایاس به کار می روند.

فرکانس ورودی W_0 : (نزدیک فرکانس میانی است) W_0 بقدری بالا است که CE

اتصال کوتاه شود.

$$\omega_0 t \quad V_i(t) = V_1 \cos$$

$$V_i(t) = 0 \quad V_1 = 0 \quad (\text{الف})$$

$$V_{BE2} = V_{BE3} = V_{DCQ} \quad \leftarrow \text{علیرغم اینکه } V_i \text{ روشن یا خاموش باشد}$$

علت زمین شدن نقطه A توسط خازن Ce است.

$$ID_C \xrightarrow{kvl} IC_2 = IC_3 = \frac{VEE - V}{RB} \Rightarrow ID_C = IC_2 = I_{se} \frac{V_{DCQ}}{V_I}$$

$$V_{DC2} = V_T \ln \frac{IC_2}{I_S}$$

$$\frac{V_{DCQ}}{V_T}$$

$$IC_1 = IC_2 \rightarrow I_{se} \frac{V_{BE1}}{V_T} = I_{se} \rightarrow V_{BE1} = V_{DCQ}$$

در زمانی که $V_1 = 0$ داریم

$$I, T \rightarrow I_{se} \frac{V_{DC2}}{V_T} = I_{se} \frac{V_{BE1}}{V_T} \Rightarrow V_{BE1} = V_{DCQ}$$

حالت دوم $(V_i(t) \neq 0) (V_1 \neq 0)$

در این حالت

$$V_{BE_1}(t) = ac + DC$$

VDC بایاس Q_1 وقتی V_i روشن است.

VDCQ بایاس Q_1 وقتی V_i خاموش باشد.

$$iE_1(t) = I_S e^{\frac{V_{BE_1}(t)}{V_T}} \Rightarrow iE_1 = I_S e^{\frac{V_1 \cos \omega_0 t + VDC}{V_T}}$$

$$\Rightarrow iE_1 = I_S e^{\frac{VDC}{V_T}} e^{\frac{V_1}{V_T} \cos \omega_0 t}$$

$$\frac{V_1}{V_T} \cos \omega_0 t \quad X \cos \omega_0 t$$

$$e = e = I_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} r I_n(x) c_1 n \omega_0 t$$

$$x = \frac{V_1}{V_T}$$

$I_j(x)$ تابع بسل فوریه اول از مرتبه j ام

$$I \rightarrow II \Rightarrow iE_1(t) = I_S I_0(x) e^{\frac{VDC}{V_T}} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2I_n(x)}{I_0(x)} \cos n \omega_0 t \right]$$

$$iE_1 DC = I_S I_0(x) e^{\frac{VDC}{V_T}}$$

از طرفی با توجه به این موضوع که جریان DC از نقطه A نمی تواند وارد خازن Ce

شود تمام آن را وارد ترانزیستور Q_2 می شود پس می توان گفت:

$$iE_1 DC = IDC = I_S I_0(x) e^{\frac{VDC}{V_T}}$$

در واقع در ترانزیستور Q_2, Q_3 به عنوان منبع جریان هستند.

و با توجه به رابطه قبل می توان V_{DC} را محاسبه کرد.

$$I_{DC} = I_{S1_0}(x) e^{\frac{V_{DC}}{V_T}} \rightarrow V_{DC} = V_T \ln \frac{I_{DC}}{I_{S1_0}(x)}$$

$$\Rightarrow V_{DC} = V_T \ln \frac{I_{DC}}{I_S} - V_T \ln I_0(x)$$

$$\rightarrow V_{DC} = V_{DC_0} - V_T \ln I_0(x)$$

نتیجه: علاوه بر اینکه سیگنال ورودی فاقد DC است ولی می تواند با بایاس Q_1 را تغییر

دهد.

مثال: اگر $V_i(t) = 260 \cos 10^6 t$ میزان جابجایی بایاس با چنین سیگنال محاسبه کنند در

مثال قبل:

$$x = \frac{V_1}{V_T} = \frac{260 \text{ mV}}{26 \text{ mV}} = 10 \Rightarrow V_T (\ln I_0(x=10)) = 210 \text{ mV}$$

توجه جابجایی 210 mV در بایاس نسبتاً بالا است. $\Rightarrow V_{DC} = V_{DC_0} - 210 \text{ mV}$

(ممکن است ترانزیستور در پرلود منفی ورودی به آستانه قطع هم برسد).

توجه شد و درست است که ولتاژ ورودی ولتاژی کاملاً ac است اما جریانی که ایجاد

می کند دارای جریان DC است که این عامل روی بایاس تاثیر می گذارد.

$$iE_1(t) = I_{DC} + I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} \cos W_0 t + I_{DC} \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} \cos 2W_0 t + \dots$$

IDC مولفه DC جریان خروجی

$$IDC \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} : \text{مولفه اصلی جریان خروجی}$$

$$IDC \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} : \text{این مولفه } n \text{ ام جریان خروجی است. (هارفوییک } n \text{ ام)}$$

- نتیجه ۲- علاوه بر این سیگنال ورودی یک سیگنال تک فرکانس است اما جریان خروجی شامل تمام هارفوییک های ورودی است.

حال اگر x را این گونه تعریف کنیم.

$$x \geq 0 \rightarrow I_0(x) > I_1(x) > I_2(x) \dots$$

- یعنی محدوده مولفه اول هارمونیک بزرگتر از دوم و دوم بزرگتر از سوم و که این به نفع ماست.

$$V_0(t) = V_{cc} - iE_1(t)RL \\ = V_{cc} - I_{DC}R_L - I_{DC}R_L \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} \cos \omega_0 t - I_{DC}R_L \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} \cos 2\omega_0 t$$

نکته که $X \geq 2,3$ باشد یا دامنه سیگنال اما ورودی از $(V_1 > 40mv)$ آنگاه هارمونیک دوم به بعد در خروجی قابل ملاحظه ای نمی شود دیگر نمی توان از آنها صرف نظر کرد به عبارت دیگر سیگنال خروجی از سیگنال ورودی فاصله می گیرد. دیگر همشکل نمی شود و اعوجاج فرکانس به وجود می آید.

تقریب: با توجه به رابطه $V_0(t)$ بدست آمده اگر شرایط نکته (۱) را بر آن اعمال کنیم

خواهیم داشت:

$$\text{if } \begin{cases} x \leq 0/1 \\ V_1 < 2/5mv \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1) \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} \approx x \\ 2) \frac{2I_2(x)}{I_0(x)}, \frac{2I_3(x)}{I_0(x)}, \dots = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{oac}(t) = -I_{DC} R_L x \cos w_0 t \Rightarrow V_{oac}(t) = -R_L \frac{I_{DC}}{VT} V_1 \cos w_0 t \\ X = \frac{V_1}{V_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_i} = -RLgmQ$$

- پس در حالت کلی می توان گفت:

$$\text{Lim L.S} = \text{SS}$$

$$X \rightarrow 0$$

نتیجه: مدار فوق در حالت کلی نمی تواند به عنوان یک تقویت کننده باشد (به ازای

هر دامنه و x ای)

* در مدار قبل تمام هارمونیک های ورودی در خروجی ظاهر می شوند و خروجی

جز اعوجاج نیست پس برای رفع این مشکل از فیلتر در خروجی استفاده می کنیم.

تقویت کننده سیگنال بزرگ باند باریک:

- برای به دست آوردن تقویت کننده سیگنال بزرگ کافی است که این گونه عمل کنیم.

(استفاده از فیلتر RLC)

- فیلترهای RLC از نوع فیلتر های باند باریک می باشند که دارای ضریب کیفیت

بالایی هستند.

یادآوری:

$$\angle V - \angle I = 0 \rightarrow \angle Z = 0$$

$$\rightarrow Z = Re + j Im \rightarrow Z(jw_0) = Re$$

پس می توان نتیجه گرفت که در فرکانس تشدید قیمت موهوی باید صفر باشد.

بررسی فیلتر :

$$\text{تشدید} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z(jw_0) = RL$$

$$\text{ضریب کیفیت} \quad B.W = \frac{1}{R_{LC}}$$

$$Q_T = \frac{w_0}{B.w} = R_L C W_0$$

(۱) توجه فیلترهای در رده باند باریک قرار می گیرند که Q_T بالایی داشته باشند. ($Q_T >$)

. (8,9,10)

(۲) تعریف Q_T در مدار و مخابرات متفاوت است.

$$Q_T = \frac{\omega_0}{\beta \cdot \omega}$$

* توجه داشته باشید که فیلتر خروجی باید روی فرکانس ورودی Tune شده باشد که

در این صورت خواهیم داشت.

$$I_C(t) = I_{DC} + I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} \cos \omega_0 t + I_{DC} \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} \cos 2\omega_0 t + \dots$$

$$V_o(t) = VCC - i_c(t) * Z(t)$$

$$\Rightarrow V_o(t) = VCC - I_{DC} |Z(j\omega_0)| - I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} |Z(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle Z(j\omega_0)) \\ - I_{DC} \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} |Z(j2\omega_0)| \cos(2\omega_0 t + \angle Z(j2\omega_0)) - \dots$$

یادآوری:

نکته $i(t) = I_1 \cos \omega_1(t)$

$$V_o(t) = i(t) * Z(t) = I_1 |Z(j\omega_1)| \cos(\omega_1 t + \angle Z(j\omega_1))$$

اگر ضریب کیفیت بالا باشد $|Z(j2\omega_0)|$ و بعد از آن صفر می شود.

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0 \rightarrow Z(j\omega) = RL$$

$$V_o(t) = V_{CC} - I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} R_L \cos \omega_0 t$$

در این حالت فیلتر باعث شد که هارمونیک های دیگر حذف شوند و تنها هارمونیکی

تقویت شده ورودی در خروجی باقی مانده در این وضعیت یک تقویت کننده سیگنال بزرگ (غیر خطی) داریم.

(فیلتر بر روی ولتاژ تأثیری می گذارد).

(b) فرض کنید که فیلتر tune شده باشد بر روی $(2\omega_0)$ و ضریب کیفیت بالا باشد.

$$\text{یعنی} \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\omega_0 \\ Q_T \text{ بالا} \end{cases}$$

در این وضعیت فیلتر به سمت فرکانس $2\omega_0$ شیفت پیدا می کند.

$$V_o(t) = V_{CC} - I_{DC} |Z(j\omega_0)| - I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} |Z(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle Z(j\omega_0)) \\ - I_{DC} \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} |Z(j2\omega_0)| \cos(2\omega_0 t + \angle Z(j2\omega_0))$$

با توجه به رابطه b داشته باشیم

هارمونیک سوم می ماند:

$$V_o(t) = V_{CC} - I_{DC} \frac{2I_2(x)}{I_0(x)} R_L \cos 2\omega_0 t$$

- در این وضعیت تقویت کننده نخواهیم داشت چون ورودی و خروجی در یک

فرکانس نیستند (شرط تقویت کننده بودن)

(c) در صورتی که فیلتر به مولفه اصلی ورودی Tune شده بود داشتیم:

$$Voac(t) = I_{DC} \frac{2I_1(x)}{I_0(x)} R_L \cos w_0 t \rightarrow \times \frac{x}{x} \Rightarrow$$

$$Voac(t) = I_{DC} \frac{2I_1(x)}{xI_0(x)} R_L X \cos w_0 t, X = \frac{V_1}{V_T}$$

$$\Rightarrow Voac(t) = \frac{I_{DC}}{V_T} \frac{2I_1(x)}{xI_0(x)} R_L \cos w_0 t$$

$$G_m(x) = \frac{I_{DC}}{V_T} \frac{2I_1(x)}{xI_0(x)}$$

$$\Rightarrow G_m(x) = gmQ \frac{2I_1(x)}{xI_0(x)}$$

$$\Rightarrow Voac(t) = RL G_m(x) V_1 \cos w_0 t \rightarrow$$

* نتیجه کلی اگر فیلتر خروجی به مولفه اصلی ورودی Tune شود می توان به جای

کنتور منبع جریان $G_m(x) V_1 \cos w_0 t$ را قرار دهیم. $G_m(x)$ فقط مربوط به مولفه اصلی

است.

$G_m(x)$: کانداکتانس انتقالی مولفه اول ولتاژ ورودی را به جریان مولفه اول خروجی

تبدیل می کند.

$$\frac{IC_1}{Vi(t)} = \frac{G_m(x)V_1 \cos w.t}{V_1 \cos w.t} = G_m(x)$$

$$\frac{G_m(x)}{g_{MQ}} = \frac{2I_1(x)}{XT_0(x)}$$

مثال: برای فیلتر زیر رابطه ای برای $V_o(t)$ بیابید.

$$I_{CQ} = I_{DC} = \frac{10 - 0.7}{5.1} = 1.8MA$$

$$g_{MQ} = \frac{I_{DC}}{V_T} = \frac{1.8MA}{26MA}$$

فیلتر دقیقاً روی w_0 Tune شده تقویت کننده است.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6} \times 10^{-10}}} = \frac{1}{10^{-8}} = 10^8 \\ Q_T = R_L C w_0 = 2 \times 10^3 \times 10^8 \times 10^{-10} = 20 \end{array} \right. \quad \text{بالا است}$$

- پس تنها هارمونیک اول خروجی باقی خواهد ماند.

خروجی روی مولفه اصلی Tune شد.

$$Voac(t) = RL G_m(x) v_1 C_1 w.t$$

$$x = \frac{V_1}{V_2} = \frac{130^{mv}}{26^{mv}} = 5$$

$$\text{طبق جدول} \quad \frac{G_m(x)}{g_{MQ}} = 0.36 \Rightarrow G_m(x) = 0.36 g_{MQ} = 0.36 \times 0.7 = 25$$

$$\Rightarrow Voac(t) = 25^{mv} \times 2^k \times 130 \cos_1 10^8 t = 6/5 Q 10^8 t$$

$$\Rightarrow Vo(t) = V_{cc} - Voac(t) = 10 - 6/5 \cos 10^8 t$$

$$Av = \frac{6/5^v}{130^{mv}} = 50$$

فیلترهای تشدید:

مدارات تشدید هم سلف و هم خازن دارند تا سلف با ایجاد امپدانس مثبت و خازن با

ایجاد امپدانس منفی به گونه ای صفر شوند و تشدید صورت گیرد.

* به طور کلی امپدانس کلی فیلترهای تشدید تابع مختلط از فرکانس است اگر این

زاویه (I_m) تابع مختلط ($|Z|$) فقط در یک فرکانس برابر صفر شود فیلتر تشدید

(رزنانس) خواهیم داشت.

$$\text{Im } Z(j\omega) = 0 \Rightarrow Z(j\omega) = \text{حقیقی}$$

$$Z(j\omega) = \text{حقیقی} = R_T \rightarrow \text{Tank}$$

* فیلترهای تشدید به دلیل داشتن عناصر ذخیره کننده انرژی به مدارات Tank معروفند.

* در حالت کلی تحلیل فیلترهای تشدید روابط بسیار طولانی دارند.

به همین دلیل جداولی تهیه شده تحت شرایط خاصی این فیلترها را مدل می کنند. (به

RLC موازی مدل می کند).

* مدار معادل شبه ترانس فورماتوری: در تجزیه و تحلیل فیلترهای باند باریک هر

فیلتر تشدید را با یک مدار LC موازی همراه با یک ترانس ایده ال جایگزین می کنیم.

به چنین مدلی مدار شبه ترانسفورماتور می گویند.

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad C_r = \frac{C_1 + C_2}{C_1 + C_2}$$

مقاومت R_T به n بستگی دارد با انتقال R_L به سمت اولیه.

- اگر QT بزرگتر از ۱۰ باشد روابط برقرار است.

$$\begin{cases} L = L_1 + L_2 \\ w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ n = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \end{cases}$$

- به طور معمولی اگر ضریب کیفیت به قدر کافی بزرگ باشد ($Q > 10, 7, 9$) شرایط

تبدیل برقرار است.

مثال:

$$I(t) = 2^{MA} \cos 10^7 t$$

$$L = 10 \mu H$$

$$C_1 = C_2 = 200 PF$$

$$R_2 = 0.5 k\Omega$$

در شکل بالا مقادیر V_1 و V_2 را بدست آورید.

قرار دادن مدل شبه ترانس

V_1 و V_2 غیر صفر هستند چون با فرکانس $i(t)$ یکی است.

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 1nf$$

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5} \times 10^{-9}}} = \frac{1}{10^{-7}} = 10^7 \rightarrow$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1}{2}$$

چون فرکانس تشدید فیلتر و فرکانس جریان ورودی یکی است بنابراین:

$$V_1 = i(t)R_T$$

- در فرکانس تشدید L و C مدار باز هستند پس:

$$V_1 = i(t)R_T = 4 \cos 10^7 t$$

$$QT = RT.C.W_0 = 2^k \times 1^{nf} \times 10^7 = 20 \text{ و بزرگ است } \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{n} \Rightarrow V_2 = \frac{1}{2} V_1$$

(b) در مثال قبل اگر: $i(t) = 2^{ma} \cos 10^7 t + 2^{ma} \cos 10^8 t$ باشد مثال را تکرار کنیم.

در این وضعیت چون فرکانس تشدید روی 10^7 Tune است. تنها این مولفه باقی می ماند و مولفه های دیگر حذف می شود و روابط مثل قبل باقی می ماند.

$$V_1(t) = i(t)R_T = 4 \cos 10^7 t$$

برای مدارات با Q_L و Q_C به صورت زیر رفتار می شود.

$$r = \frac{w.L}{QL}$$

$$RP = Q_L^2 . r$$

شرط

$$QL > 10$$

$$r = \frac{1}{CW.QC}$$

$$RP = r Q_C^2$$

$$Q_C > 10$$

در سلف و خازن های ایده آل $QC = \infty, QL = \infty$ می باشد.

مثال: در فیلتر رزنانس زیر خازن

$$QC = 200$$

$$QL = 80$$

$$R = 20^{\Omega}$$

$$W_0 = 60 \times 10^6$$

$$C = 25 Pf$$

ضریب کیفیت و پهنای با مدار محاسبه کنید.

$$QL, QC > 10$$

$$RT = R \parallel R_{pc} \parallel R_{pl}$$

$$W_0 = 60 \times 10^6 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{(60 \times 10^6)^2 \times C} = 11/1 \mu H$$

$$rL = \frac{W_0 L}{Q_1} = 8/33 \Omega, \quad rC = \frac{1}{w \cdot C Q_C} = 3/33 \Omega$$

$$R_{pc} = rC \cdot Q_C^2 = 133^m$$

$$R_{pl} = rL \cdot Q_L^2 = 53^{kn}$$

$$\Rightarrow RT = 20^k \parallel 53^h \parallel 133^k = 13/1^k$$

- چون سلف و خازن ایده آل نیستند R_T کم شد (از ۲۰ کمتر شد در حالت ایده آل) به

همین صورت ضریب کیفیت نیز کاهش خواهد یافت.

$$QT = R_T \cdot C \cdot W_0 = 13/1 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-12} \times 60 \times 10^6$$

$$BW = \frac{1}{RT \cdot C} = \frac{1}{13/1 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-12}} =$$

مثال:

$$i(t) = 1^m \cos 10^7 t$$

$$L_2 = 100 \mu, R_2 = 400^k$$

$$m_{12} = 10, M_{23} = 0/5, j = 10 \Omega$$

$$C = 100 pf, L_1 = 2 \mu$$

مقدار M_{23} را به گونه ای بیابید که ولتاژ خروجی Max شود مقادیر V_{o1} و V_{o2} را

محاسبه کنید.

رابطه شبه ترانس L_2, L_1 : در حالت اول سلفی که دست نخورده می ماند سلفی است

که خازن می بیند پس:

$$n' = \frac{M_{12}}{L_2} \quad \frac{i(t)}{i_2(t)} = \frac{1}{n'} = i_2(t) = n' i(t)$$

$$\Rightarrow i_2(t) = \frac{M_{12}}{L_2} i(t)$$

مدل شبه ترانس L_2, L_3

$$i_2(t) = \frac{10^4}{100^4} 1^m \cos 10^7$$

$$\text{پس مولفه ولتاژ خروجی را داریم } w = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-4} \times 10^{-10}}} = 10^7 \text{ تشدید}$$

* نکته مهم برای اینکه حداکثر توان به بار منتقل شود. (دامنه خروجی روی بار

بیشترین مقدار شود) در این صورت اگر بخواهیم بار را انتخاب کنیم کافی است:

$$z \rightarrow z' = z^* \text{ محاسبه می کنیم.}$$

نکته: برای داشتن حداکثر توان در خروجی یا داشتن حداکثر دامنه ولتاژ شرط این

است $R3' = R3$ باشد.

$$R3' = R_2 \left(\frac{n}{1} \right)^2 \Rightarrow R_2 n^2 = R3 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{R3}{R2}}$$

$$= n = \sqrt{\frac{10^{\Omega}}{4 \times 10^5}} = 0.005$$

$$\Rightarrow n = \frac{M_{23}}{L_2} \Rightarrow M_{23} = \frac{1}{2} \mu H$$

از روی (K_{23}) ضریب ترویج می توان L_3 را محاسبه کرد.

$$M_{23} = K_{23} \sqrt{L_2 L_3} \Rightarrow L_3 = \frac{M_{23}^2}{K_{23}^2 L_2} = 10 nh$$

(ب)

چون شرط ماکزیمم توان داشته:

$$RT = R_2 \parallel R_3 \left(\frac{1}{n} \right)^2 = 200^k$$

$$V_{o2}(t) = \frac{M_{12}}{L_1} = i(t)RT = 0/1 \times 1^{ma} \times 200^k \cos 10^7 t$$

$$\Rightarrow V_{o2}(t) = 20 \cos 10^7 t$$

$$\Rightarrow \frac{V_{o2}}{V_o} = \frac{1}{n} \Rightarrow V_o = n V_{o2} \Rightarrow V_o(t) = 0/1 \cos 10^7 t$$

$$\Rightarrow \frac{V_{o1}}{V_{o2}} = \frac{n'}{1} \Rightarrow V_{o1} = V_{o2}(n') = 0.1 V_{o2} = 2 \cos 10^7 t$$

$$Q_T = R_T C \omega_0 = 2 \times 10^5 \times 10^{-10} \times 10^7 = 200$$

توجه: مقادیر L_3, L_1 در تعیین فرکانس رزونانس بی تاثیر هستند و تاثیر آنها از طریق M

روی مقاومت Tank است.

$$M_{12} = K_{12} \sqrt{L_1 L_2}$$

اسیلاتورها:

با تغییر و تحول کوچکی در مدار بخش مقدمه می توانیم اسیلاتور بسازیم کافی است

که سه عمل زیر را روی مدار بخش مقدمه انجام دهیم.

۱- حذف ورودی

۲- فیدبکی از خروجی به ورودی وصل می کنیم.

۳- تقسیم خازن به دو قسمت

در این صورت اسیلاتور خواهیم داشت.

(Colpits) اسیلاتور کولپیتس

* اگر به جای این کار سلف را به دو قسمت تقسیم کنیم اسیلاتور هارتلی خواهیم داشت.

$$\text{Colpits : DC} = IDC = \frac{VEE - 0.7}{RE}$$

چون مدار اسیلاتور است پس فرکانس V_o, V_f, V_i همه یکسان است. پس:

$$T = \frac{V_f}{V_i}$$

$$V_o(t) = V_o \cos \omega_0 L$$

$$V_o(t) = V_1 \cos \omega t$$

$$V_f(t) = V_f \cos \omega t$$

چون سیگنال $V_o(t), V_1(t)$ نیم فرکانس هستند می توان به جای کلکتور $G_m(x)V_{be}(t)$ را

قرار داد.

$$V_{be}(t) = V_1(t)$$

$$c(t) = G_m(x)V_{be}(t) = G_m(x)V_1(t)$$

- حذف تقویت کننده و قرار دادن اثر بارگذاری آن بر روی β

پس

$$Z : re = \frac{r_\pi}{\beta} = \frac{1}{g_{mQ}} \Rightarrow Y = g_{mQ} / \alpha$$

$$L : S \quad Y = \frac{G_m(x)}{\alpha}$$

اثر بارگذاری A بر روی B لحاظ شد.

حال مدل شبیه ترانس C_1, C_2 را قرار می دهیم.

معمولاً $\alpha = 1$ در نظر می گیریم.

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

فرکانس نوسان $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ تشدید

$$G_T = G_L + \left(\frac{n}{1}\right)^2 G_E + \left(\frac{n}{1}\right)^2 \frac{G_m(x)}{\alpha} \rightarrow R_T = \frac{1}{G_T}$$

$$V_o(t) = R_T G_m(x) V_1 \cos \omega t = \frac{G_m(x) V_1 \cos \omega t}{G_T}$$

$$\frac{V_o}{V_f} = \frac{1}{n} \Rightarrow V_f = nV_o =$$

$$V_1(t) = V_1 \cos W.t$$

$$T = \frac{V_f(t)}{V_1(t)} = \frac{nGm(x)}{\left(G_L + \left(\frac{n}{1} \right)^2 \left(G_E + \frac{Gm(x)}{\alpha} \right) \right)}$$

شرط نوسان $|T(jw_0)| = 1 \rightarrow \frac{nGm(x)}{G_L + (n)^2 \left(G_E + \frac{Gm(x)}{\alpha} \right)}$

$$\Rightarrow \text{شرط نوسان} = Gm(x) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(1 - \frac{n}{\alpha} \right)}$$

(اسیلاتور به ازای X ای پایدار می شود که در شرط نوسان برقرار باشد.)

$$if \rightarrow RE \rightarrow I_{DC} \Rightarrow RE = 0$$

$$G_E = 0 \Rightarrow Gm(x) = \frac{G_L}{n \left(1 - \frac{n}{\alpha} \right)}$$

- اگر منبع جریانی که به جای کلکتوز قرار می دهیم ضریب داشته باشد به این

صورت که:

$$AGm(x)V_1 \cos W.t$$

در این صورت

$$Gm(x) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(A - \frac{n}{\alpha} \right)}$$

$$V_1 = xVT = 3/5 \times 26^{mv} = 91^{mv}$$

$$V_e(t) = V_1 \cos W.t = 91^{mv} C_1 10^7 t$$

$$\frac{V_o(t)}{V_e(t)} = \frac{1}{n} \Rightarrow V_{oac}(t) = \frac{1}{n} V_e(t) = 7.16^{mv} \cos 10^9 t$$

جهت خرید فایل word به سایت www.kandoo.cn.com مراجعه کنید
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۵۱۱ تماس حاصل نمایید

$$\text{پس } V_o(t) = V_{cc} - V_{oac}(t) = 10 - 7/16 \cos 10^7$$

$$\text{نکته active} \begin{cases} DBE = f \\ DBC = R \end{cases}$$

- در غیر این صورت ممکن قسمتی در شکل موج بریده شود.

$$Q_T = RTC\omega_0$$

$$G_T = G_L + n^2 G_E + n^2 \frac{G_m(t)}{\alpha = 1}$$

$$\Rightarrow G_{T_{n \ll 1}} = G_L \Rightarrow R_L = R_T \Rightarrow QT = 10^4 \times 10^{-9} \times 10^7 = 100 \rightarrow$$

$$\text{مراحل تحلیل } gmQ \rightarrow G_m(x) \rightarrow \frac{G_m(x)}{gmQ} \rightarrow X$$

- اما مراحل طراحی بر عکس است.

ترانزیستور FET, BJT خود کنترل کن تفسیر خود می تواند فرکانس دامنه خود را

کنترل کند.

$$V_o \downarrow \rightarrow V_1 \downarrow \rightarrow x = \frac{V_1}{V_T} \downarrow \rightarrow G_m(x) \uparrow \rightarrow V_o \uparrow$$

(Total harmonic distortion) : T.H.D

- اعجاج هارمونیک های کلی: امپدانس فیلترهای باند باریک در هارمونیک های فرکانسی (تشدید) صفر است اما واقعیت اینکه این فیلتر ها در هارمونیک های فرکانسی امپدانس دارند. بنابراین ولتاژ خروجی هم دارای هارمونیک های فرکانسی است (البته می دانیم که هر چه قدر ضریب کیفیت بهتر باشد هارمونیک های فرکانسی با دامنه کمتری در خروجی ظاهر می شود).

THD : مقدار موثر هارمونیک های دوم به بعد تقسیم مقدار موثر هارمونیک اصلی

$$T.H.D = \frac{D(x)}{QT} \times 100\%$$

طراحی: یک نوسان صفر Colpits طراحی کنید که خروجی یک سیگنال سینوسی 18

VP.P و فرکانس $10^7 \left(\frac{rad}{s} \right)$ باشد اعوجاج هارمونیک کلی اسیلاتور کمتر از 1%

باشد.

۱- ابتدا انتخاب V_{cc} , V_{EE} مثلاً 10^v

۲- بعداً انتخاب RL در حد چند کیلو اهم حداکثر 6^k مثلاً

$$\begin{cases} \omega_0 = 10^7 \\ THD \leq 1\% \\ V_{OPP} = 18^v \end{cases}$$

$$RL = 3^k$$

- توجه شود اگر اول المانهای دیگر را محاسبه کنیم و سپس RL را محاسبه کنیم

ممکن است این R_L ترانزیستور را به اشباع برود.

۳- انتخاب $x = 10$ از یک طرف هر چه x بزرگتر انتخاب کنیم دامنه سیگنال امیتر بیشتر

شده و پایداری حرارتی نیز بیشتر و از طرفی با توجه به منحنی هر چه x بزرگتر باشد

$D(x)$ بزرگتر و THD هم بزرگتر.

انتخاب $X=10$

اگر THD داده شده باشد QT نیز انتخاب می کنیم (بزرگتر بهتر)

$$D(x=10) = 0/64 \rightarrow \text{جدول}$$

این مقدار QT, \min است.

$$T.H.D = \frac{D(x)}{QT} \Rightarrow 0/01 = \frac{0/64}{QT} \Rightarrow QT = 64$$

با توجه به مدل شبه ترانس

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}, R_T = R_L, n \ll 1$$

پس

$$QT = RTCW_0 = 3 \times 10^3 \times C \times 10^7 = 64$$

$$\rightarrow C = \frac{64}{3 \times 10^3 \times 10^7} = 2140 Pf$$

$$\rightarrow V_1 = xV_T = 10 \times 26^{mv} \Rightarrow V_1 = 260^{mv}$$

$$V_{op} = 9v \Rightarrow \frac{V_{op}}{V_1} = \frac{2}{n} \Rightarrow n = \frac{V_1}{V_{op}} = \frac{260^{mv}}{9v} = 0/029$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow 2140 pf \\ n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 0/029 \end{cases} \rightarrow C_1, C_2 \begin{cases} C_1 = 2/2nf \\ C_2 = 74nf \end{cases}$$

$$W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{W_0^2 C} = \frac{1}{10^{14} \times 214 \times 10^{-12}} = 4.671 \mu$$

مثال:

$$L = 10 \mu$$

$$RL = 10k$$

$$V_{cc} = V_{EE} = 10V$$

$$R_e = 20 \mu$$

$$C_2 = 79nf, C_1 = 1013 pf$$

رابطه V_0 را بدست آورید.

$$Dc = IDC = \frac{V_{cc} - 0.7}{RE} \Rightarrow I_{DC} = \frac{9.3}{20k} = 0/46mA$$

$$gmQ = \frac{I_{DC}}{V_t} = \frac{0.46mA}{26^{mv}} = 18.7^{mv}$$

شبه ترانس اسیلاتور:

$$Q_m(x) = \frac{QL + n^2 CE}{n \left(1 + \frac{n}{\alpha}\right)}$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{1012 pf}{1012 pf + 79nf} = 0/0127$$

$$G_m(x)G_m(x) = \frac{G_L}{n} = \frac{0/1}{0/0127} = 8^{mv}$$

$$\frac{G_m(x)}{gmQ} = \frac{8^{mv}}{18^{mv}} = 0/45 \rightarrow x = 3.5$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{1012 pf \times 79nf}{1012 pf + 79nf} = 1000 pf = 1^{nf}$$

$$W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5} \times 10^{-9}}} = 10^7$$

$$ifx = 10 \rightarrow \frac{G_m(10)}{gmQ} = 0/19$$

$$G_n(x) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(1 + \frac{n}{\alpha}\right)} = \frac{G_L}{n} = 3/5^{mv} \text{ شرط نوسان اسیلاتور}$$

$$\Rightarrow gmQ = \frac{G_m(x)}{0/19} = 18/7^{mv}$$

$$\begin{cases} I_{DC} = \frac{VEE - 0.7}{Re} = \frac{9/3}{RE} \\ gmQ = \frac{I_{DC}}{VT} \Rightarrow IDC = gmQVT = 0.46^{mA} \end{cases} \Rightarrow 0.46^{mA} = \frac{9.3}{RE} \Rightarrow RE = 19/1^k$$

- اگر مدار کار نکرد باید RE را مقدار از بین که بدست آمده کمتر کنیم.

مثال: اسیلاتوری طراحی کنید از نوع هارتلی با مقادیر مثال قبل،

نکته مهم: در فرکانس پایین مثل، مثال فرق خازن های C_1, C_2 مقادیرشان بزرگ بدست

می آید در حد چند هزار Pf با توجه به شکل مشخص است که خازن $C\pi$ با خازن

C2 موازی و خازن C_μ یک تاثیر روی C2 و تاثیری روی C1 مقادیر C_μ, C_π در حد

چند pf فاراد هستند بنابراین در فرکانس پایین راکتانس های داخلی (C_μ, C_π) نمی

تواند اثر بارگذاری روی خازن های خارجی داشته باشند. اما در فرکانس های بالا و

خیلی بالا، مقادیر C_1, C_2 در حد چند پیکو هستند که به شدت تحت تاثیر خازن های

داخلی قرار می گیرند (مشکل اینجاست که در حوزه سیگنال بزرگ می دانیم بین E, B

خازن داریم ولی مقدار آن را نداریم چون مدلی برای چنین خازنی در سیگنال بزرگ

نداریم).

اسیلاتور که می تواند در فرکانس بالا کار کند.

چون مدار اسیلاتور است پس فرکانس ورودی و خروجی یکی است پس به جای

کلکتور می توان یک منبع جریان قرار داد.

توجه: به جای جریان کلکتور

$$i_C(t) = G_m(x) V_1 \cos \omega_0 t$$

$$i_C = \frac{M_{12}}{L_2} \text{ طبق مدل}$$

مدل شبه ترانس L_3, L_2

$$n = \frac{M_{23}}{L_2}, W_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}}$$

$$\text{شرط نوسان} = G_m(x) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(A - \frac{n}{\alpha} \right)} = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(\frac{m_{12}}{L_2} - \frac{n}{\alpha} \right)}$$

$$\frac{G_m(x)}{gm_Q} \rightarrow I_{CQ} \rightarrow x \rightarrow V_1 = x V_T \rightarrow V_0(t)$$

- توجه شود که خازن $C\pi$ با خازن C با نسبت $\frac{M_{23}}{L_2}$ موازی شود پس در طراحی به

گونه آن را در نظر می گیریم. که اثر آن کم شود.

- برای خازن $C\mu$ $\frac{M_{12}}{L_2}$

* هر چقدر ضرایب $\frac{M_{12}}{L_2}, \frac{M_{23}}{L_2}$ کمتر انتخاب کنیم به ترتیب اثر خازن های C_μ, C_π

روی خازن C کمتر می شود اما توجه شود هر چه این نسبت ها کمتر شود دامنه ها

کمتر خواهد شد.

مثال: مطلوب است $V_0, TH.D$

$$L_1 = 10^\mu, L_2 = 250^\mu, C_2 = 40nf$$

$$RL = 100^n, m_{12} = 25^\mu, C_1 = 200pf$$

مدل شبه ترانس خازن های C_1, C_2

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2}, C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 200pf$$

$$W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4.47 \times 10^6 = 4.5 \times 10^6$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 4.46 \times 10^{-3}$$

$$Gm(x) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(\frac{m_{12}}{L_2} - \frac{n}{\alpha} \right)} = 21.2 Mv$$

$$V_B = V_{cc} \cdot \frac{2.2}{2.2 + 15} = 1/53V$$

$$V_E = V_B = 0.7 - 0/83 \Rightarrow ICQ = \frac{V_E}{R_E} = . / 8mA$$

$$\rightarrow gmQ = \frac{ICQ}{V_T} = \frac{0/8mA}{26^{mv}} = 30^{mv}$$

$$\frac{Gm(x)}{gmQ} = \frac{21/2^{mv}}{30^{mn}} - 0/7 \Rightarrow x = 2 \rightarrow V_1 = xV_T$$

$$\Rightarrow V_1(t) = 52^{mv} \cos 4/5 \times 10^6 t$$

$$\text{از طرفی } \frac{V_o}{V_1} = \frac{1}{n} \rightarrow Vo(t) = 10.7 \cos 4/5 \times 10^6 t$$

$$G_T = G_L + \frac{n^2}{1} G_E + \frac{n^2}{1} \frac{Gm(x)}{\alpha} = G_L \Rightarrow R_T = R_L$$

$$\Rightarrow QT = R_T Cw_0 = 10^5 \times 2 \times 10^{-10} \times 4.5 \times 10^6 = 90 \text{ بزرگ}$$

$$\begin{cases} x = 2 \rightarrow D(x = 2) = ? \\ T.H.D = 100 \times \frac{D(x = 2)}{QT} \% = \frac{D(x = 2)}{90} \times 100 \end{cases}$$

$$L_1 = 10 \mu, L_2 = \frac{1}{160} \mu$$

$$M = 0/25$$

در مدار شکل زیر مقدار V_o را بیابید.

مدل شبه ترانس L_2, L_1

$$n = \frac{M_{12}}{L_1} = 0/025, W_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^7 \quad \text{- ۵ ولت تا اشباع ناحیه داریم.}$$

$$Gm(0) = \frac{G_L + n^2 G_E}{n \left(1 - \frac{n}{\alpha} \right)} = 20mV \quad \text{حداقل مقدار } 12 - 3,3 = 8^v$$

$$8 - 2/75 = 5^v$$

$$DC \begin{cases} V_B = V_{CC} \frac{2/7}{2/7 + 9/1} = 2/75 \rightarrow V_E = V_B - 0.7 = \\ I_{CQ} = \frac{V_E}{R_E} = 1^{mA} \rightarrow gm_Q = \frac{I_{CQ}}{V_t} = 39^{mv} \end{cases}$$

$$\frac{Gm(x)}{gm_Q} = \frac{20}{38} = 0/52 \rightarrow n = 3/2$$

$$\rightarrow V_1 = xV_2 = 83/2^{mv}$$

$$V_1 = 83/2^{mv} \cos 10^7 t$$

$$V_o = \frac{1}{n} V_1 = \frac{1}{0/025} (83/2^{mv}) \cos 10^7 t$$

$$V_o(t) = V_{CC} - V_{oac}(t) = 12 - 3/2 \cos 10^7 t \quad , T.H.D$$

$$\left\{ \begin{aligned} TH.D &= \frac{D(x=3/2)}{QT} \times 100\% = 2\% \\ D(x=3/2) &= 0/41 \end{aligned} \right.$$

$$QT = RTCW_0 = 20$$

* اسیلاتور دیفرانسیلی:

- جریان های زوج های دیفرانسیل فاقد هارمونیک های زوج ورودی است به همین

دلیل اسیلاتورهای زوج دیفرانسیل دارای THD بسیار کوچکی هستند (نسبت به BJT)

و در مدولاتورهای fm می توان از آنها استفاده کرد.

فیدبک به بیس متصل شده پس اثر آن را بررسی می کنیم (اثر بارگذاری تقویت کننده

روی شبکه).

جهت خرید فایل word به سایت www.kandoocn.com مراجعه کنید
یا با شماره های ۰۹۳۶۶۰۲۷۴۱۷ و ۰۹۳۶۶۴۰۶۸۵۷ و ۰۶۶۴۱۲۶۰-۵۱۱ تماس حاصل نمایید

Filename: Document1
Directory:
Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: مدار مخابراتی
Subject:
Author: dehghanizadeh
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/28/2012 4:54:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On:
Last Saved By: H.H
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 3/28/2012 4:55:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 28
Number of Words: 2,134 (approx.)
Number of Characters: 12,166 (approx.)